

SS 125 · SS 126

Nicht für Neuentwicklungen ■

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren für den Einsatz als Schalttransistoren in der Datenverarbeitungstechnik.

Bauform 1 TO39

$$R_{thja} \leq 0,29 \text{ K/W}$$

$$R_{thjc} \leq 0,07 \text{ K/W}$$

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SS 125	SS 126
U_{CBO}	30	60 V
U_{CEO}	25	50 V
U_{EBO}	5	5 V
I_C	500	500 mA
P_{tot} ($\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$)	600	600 mW
ϑ_j	175	175 °C

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 20 \text{ V}$)	SS 125	25 nA
	(bei $U_{CB} = 40 \text{ V}$)	SS 126	25 nA
$U_{CE \text{ sat}}$	(bei $I_C = 400 \text{ mA}$; $I_B = 40 \text{ mA}$)		$\leq 1 \text{ V}$
$h_{21 E}$	(bei $I_C = 400 \text{ mA}$; $U_{CE} = 1 \text{ V}$)	A...C	18...140